










	FQD20N06LETM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD20N06LETM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1.FQD20N06LETM.pdf  2.FQD20N06LETM.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 10000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06LETM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17.2A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD20N06LETM ist neu im Original, Suche FQD20N06LETM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06LETM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06LETM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06LE FAI FQD20N06LE FAI</p>	 <p>FQD20N06 F FQD20N06 F</p>	 <p>FQD20N06LTU VB FQD20N06LTU VB</p>	 <p>FQD20N06L FCS FQD20N06L FCS</p>
 <p>FQD20N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD19N10LTM	 FQD19N10TF	 FQD19N10TF	 FQD19N10TM	 FQD19N10TM
 FQD1N50B	 FQD1N50TF	 FQD1N50TF	 FQD1N60C	 FQD1N60CTF
 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTM	 FQD1N60CTM	 FQD1N60TF	 FQD1N60TF
 FQD1N60TM	 FQD1N60TM	 FQD1N80TM	 FQD1N80TM	 FQD1P50TM
 FQD1P50TM	 FQD20N06	 FQD20N06-NL	 FQD20N06L	 FQD20N06LE
 FQD20N06LETM	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTM
 FQD20N06LTU	 FQD20N06TF	 FQD20N06TF	 FQD20N06TM	 FQD20N06TM
 FQD24N08	 FQD24N08TF	 FQD24N08TF	 FQD24N08TM	 FQD24N08TM
 FQD2N100	 FQD2N100TM	 FQD2N100TM	 FQD2N30TF	 FQD2N40TM
 FQD2N40TM	 FQD2N50B	 FQD2N50C	 FQD2N50TF	 FQD2N50TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited